

Características Gerais

Código Fabrica	Código Produto	Encapsulamento	Tecnologia do chip
710.004	C860TP	Termoplástico	AlGaAs/GaAs - Si

Características Máximas Absolutas - T_{AMB}: 25 °C

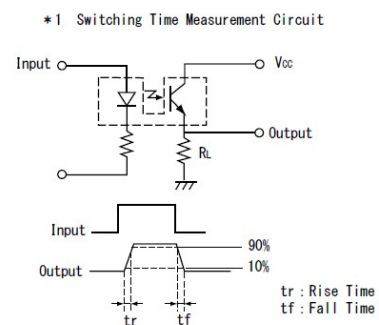
		Símbolo	Valor	Unidade
Emissor	Potência dissipada	Pd	100	mW
	Tensão reversa	Vr	5	V
	Corrente Direta	If	60	mA
	Corrente direta de pico (100us:10ms)	Ifp	250	mA
Sensor	Potência dissipada coletor-emissor	Pc	100	mW
	Corrente de coletor	Ic	60	mA
	Tensão C-E	Vceo	30	V
	Tensão E-C	Veco	6,0	V
Temperatura de operação		Topr	-20 a +75	°C
Temperatura de armazenagem		Tstg	-25 a +85	°C
Temperatura de solda (t < 3s)		Tsld	260	°C

Características de Operação - T_{AMB}: 25 °C

Parâmetro		símbolo	condição	Min	Típ	Max	Unid.
Emissor	Tensão direta	Vf	If= 50mA	-	1,3	1,6	V
	Corrente reversa	Ir	Vr= 5V	-	-	10	uA
	Comprimento de onda - efetivo			-	940	-	nm
Sensor	Corrente de "escuro"	Id	Vce= 10V	-	-	0,1	uA
	Pico de sensibilidade			930		950	nm
	Tensão de saturação C-E	Vce(sat)	Ic= 0,5mA If= 20mA	-	-	0,4	V
Corrente de "claro"		IL	Vce= 5V If= 20mA	0,3	-	-	mA
CTR			Vce= 5V If= 20mA	20	-	-	%
Tempo de resposta		T _R - T _F	If= 20mA Vcc= 5V RI= 1 KOhm	-	20	-	µs

Nota importante:

Os níveis de ganho das chaves, da forma que são entregues, atendem à maioria das aplicações. Entretanto para aplicações mais críticas onde é necessário maior uniformidade entre os componentes, é sugerido contatar nosso departamento comercial para solicitação da classificação das chaves.



Tipo de fornecimento	À granel
Tipo de Embalagem	Saco polietileno (comum)
Quantidade padrão por embalagem	200 unidades

Nota: características suscetíveis à mudança sem aviso prévio.

Preparado por:	Data:	Revisão:	Aprovado:
Bruna Bezerra	30/05/2019	02	Milton Shimomi